

大見研究室 和文 論文リスト

1995 年

- 604(M) 大見忠弘、小谷光司、島田久幸、「リソグラフィ技術のトレンド」、O plus E, No.182、(株)新技術コミュニケーションズ)、pp.68-77、1995 年 1 月。
- 605(M) 大見忠弘、「一巻頭言ーマイクロエレクトロニクス分野における日米 Equal Partnershipの時代を目指して」、ブレイクスルー、No.103、(株)リアライズ社)、pp.12-16、1995 年 1 月。
- 606(P) 大見忠弘、「半導体産業から化学工業への要望」、クリーン化テクノロジー講演会、(化学工学会関東支部)、pp.1-5、1995 年 1 月。
- 607(W) 中村雅一、大木厚志、川田幸司、平尾圭志、日置晃、渡辺剛、Micheal S.K.Chen、大見忠弘、「半導体材料表面における特殊材料ガスの反応に関する研究」、第 5 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.1-10、1995 年 1 月。
- 608(W) 宮脇守、大見忠弘、「ニューロン MOS を用いた並列画像信号処理回路の研究」、第 5 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.17-23、1995 年 1 月。
- 609(W) 板野充司、毛塚建彦、久保元伸、大見忠弘、「半導体ウエット洗浄プロセスにおける粒子の吸着・脱離に関する研究」、第 5 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.31-37、1995 年 1 月。
- 610(W) 森永均、陶山誠、能瀬昌之、大見忠弘、「液中金属不純物の Si 表面への吸着・脱離挙動と高性能ウエット洗浄技術によるその制御」、第 5 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.38-44、1995 年 1 月。
- 611(M) 松浦孝、室田淳一、澤田康次、大見忠弘、「塩素吸着とArイオン照射を用いたSiのエッチング」、応用物理、Vol.64、No.2、((社)応用物理学会)、pp.159-160、1995 年 2 月。
- 612(M) 大見忠弘、小島泉里、「オゾンの半導体工業への応用(I)」、クリーンテクノロジー、Vol.5、No.3、(日本工業出版)、pp.38-44、1995 年 3 月。
- 613(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 24序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1995 年 3 月。
- 614(P) 大見忠弘、「半導体プロセスシミュレーションとUCT」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-13、1995 年 3 月。
- 615(P) 久保和樹、小島泉里、泉浩人、能勢昌之、大見忠弘、「Advanced Wet Treatment System」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 24、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.83-91、1995 年 3 月。
- 616(M) 大見忠弘、「新しい洗浄技術」、電気化学および工業物理化学、Vol.63、No.3、(電気化学協会)、pp.184-188、1995 年 3 月。
- 617(P) 大見忠弘、「一巻頭言ー新しいウエットプロセス洗浄技術を目指して」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.7、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp. 2-6、1995 年 4 月。
- 618(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーの新展開、半導体表面の電子化学」、結晶加工と評価技術第145委員会、(日本学術振興会)、pp.4-22、1995 年 3 月。
- 619(P) 小谷光司、柴田直、今井誠、大見忠弘、「自動しきい値調整機能を用いたクロック制御ニューロンMOS論理回路」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.95、No.24、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 CPSY95-8、FT95-8、ICD95-8、pp.57-64、1995 年 4 月。
- 620(P) 大見忠弘、柴田直、「知的な機能を備えた集積回路」、並列処理シンポジウムJSPS' 95、Vol.95、No.2、(情報処理学会)、pp.1-9、1995 年 5 月。

- 621(P) 大見忠弘、「高性能・高信頼・低価格ガス供給システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-12、1995年5月。
- 622(P) 白井泰雪、植崎勝貴、大見忠弘、「ステンレス配管システムの酸化クロム不動態化処理、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.21-35、1995年5月。
- 623(P) 小嶋努、米華克典、三好伸二、大見忠弘、「溶接部と腐食」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.37-59、1995年5月。
- 624(P) 池田信一、篠原努、山路道雄、大見忠弘、「インスペクションフリーを実現する高性能継手」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.115-126、1995年5月。
- 625(P) 大見忠弘、「低エネルギーイオン照射による低温・高品質薄膜形成技術」、薄膜第131委員会第177回研究会・第8回磁性薄膜研究会資料、(日本学術振興会)、pp.39-43、1995年6月。
- 626(P) 柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOSトランジスタで実現するしなやかな情報処理電子回路」、極限構造電子物性第151委員会第34回研究会資料、(日本学術振興会)、pp.40-48、1995年6月。
- 627(P) 大見忠弘、「一巻頭言ーLSI技術における絶縁膜の役割」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.7、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-3、1995年6月。
- 628(P) 河合泰明、小西信博、渡辺仁三、大見忠弘、「低エネルギーイオンを用いた低温ゲート酸化膜」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.7、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-3、1995年6月。
- 629(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンTFT-LCDプロセス」、セミコン関西95PFD技術セミナー講演予稿集、(SEMIジャパン)、pp.23-27、1995年6月。
- 630(M) 大見忠弘、能勢昌之、「液中粒子の挙動と表面付着制御」、クリーンテクノロジー、Vol.5、No.7、(日本工業出版)、pp.39-42、1995年7月。
- 631(P) 大見忠弘、「次世代プロセスにおける超クリーン化、低温化の必要性」、日本学術振興会第145委員会本委員会第71回研究会資料、(日本学術振興会)pp.5-10、1995年7月。
- 632(P) 大見忠弘、新田雄久、「新しい表面洗浄と計測技術を求めて、序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1995年7月。
- 633(P) 大見忠弘、「半導体表面の電子化学」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-18、1995年7月。
- 634(P) 都田昌之、加藤正行、三森健一、大見忠弘、「メガソニック励起純水の化学」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.19-32、1995年7月。
- 635(P) 大見忠弘、「RCA洗浄にかわる新しい洗浄技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.33-43、1995年7月。
- 636(P) 泉浩人、前野又五郎、中川佳紀、久次米孝信、大見忠弘、「フッ素系薬液によるウェハクリーニングとメガソニックフッ酸工程用金属容器」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.44-51、1995年7月。
- 637(P) 宮下雅之、菊山裕久、泉浩人、山根香代、久次米孝信、大見忠弘、「ウェットプロセス制御のための薬液組成管理方法」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.76-85、1995年7月。
- 638(P) 三森健一、呉義烈、笠間泰彦、今岡孝之、吉澤道雄、中山弘次、加藤正行、都田昌之、小島泉里、久保和樹、森田博志、大見忠弘、「電解イオン水を用いた新しい洗浄技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 25、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.86-101、1995年7月。
- 639(M) 大見忠弘、森田瑞穂、「第2章インプロセス制御、光制御 第1節センシング技術」、超精密生産技術大系第3巻計測制御技術、(株)フジテクノシステム)、pp.430-438、1995年7月。

- 640(B) 大見忠弘、「半導体・液晶を革新する新しいフッ素化学、序文」、大見忠弘編著、新田雄久、三木正博共編、フッ素化学が拓くプロセスイノベーション、(株リアライズ社)、pp.1-2、1995年7月。
- 641(B) 川田幸司、大見忠弘、「第2編第2章第5節 WF₆によるSiH₄還元型選択W-CVDの物理化学」、大見忠弘編著、新田雄久、三木正博共編、フッ素化学が拓くプロセスイノベーション、(株リアライズ社)、pp.94-101、1995年7月。
- 642(B) 伊野和英、大見忠弘、「第2編第2章第6節 NF₃プラズマによるプロセスチャンバの in-situ クリーニング」、大見忠弘編著、新田雄久、三木正博共編、フッ素化学が拓くプロセスイノベーション、(株リアライズ社)、pp.102-107、1995年7月。
- 643(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーン技術と触媒 電子工学からのメッセージ」、第26回触媒サマーセミナー講演要旨及び資料集、(触媒学会)、pp.1-23、1995年8月。
- 644(M) 大見忠弘、「極限集積化シリコン知能エレクトロニクス」、計測と制御、Vol.34、No.8、(計測自動制御学会)、pp.676-677、1995年8月。
- 645(M) 竹脇利至、大見忠弘、新田雄久、「サブクォータマイクロンLSIへ向けての多層銅配線技術」、ブレイクスルー、Vol. 8-9、No.110-111、(リアライズ社)、pp.11-15、1995年8月。
- 646(P) 笠間泰彦、大見忠弘、福田航一、福井洋文、岩崎千里、小野昭一、「照射ion energyの制御によるTFT gate絶縁膜用PECVD-SiN_xの高品質化」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.95、No.205、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-96、pp.21-27、1995年8月。
- 647(P) 今岡孝之、小島泉里、久保和樹、森田博志、大見忠弘、三森健一、呉義烈、笠間泰彦、吉澤道雄、山中弘次、加藤正行、都田昌之、「電解イオン水を用いた新しい洗浄技術(TFT-LCDプロセスへの応用)」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.95、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-102、pp.1-8、1995年8月。
- 648(P) 國本文智、今岡孝之、笠間泰彦、大見忠弘、加藤正行、都田昌之、呉義烈、山中弘次、「活性ラジカル溶液による基板表面洗浄システム」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.95、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-103、pp.9-16、1995年8月。
- 649(P) 大木厚志、大見忠弘、「シランガス中における水分とシロキサン計測ならびにその挙動」、電子情報通信学会技術報告、Vol.95、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-106、pp.27-33、1995年8月。
- 650(P) 池田信一、篠原努、山路道雄、大見忠弘、「高メンテナンス性を有する半導体製造用高性能ガスパネルシステム」、電子情報通信学会技術報告、Vol.95、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-107、pp.35-41、1995年8月。
- 651(P) 佐藤雅幸、大見忠弘、「誘導結合プラズマによる酸化膜のエッチング特性」、電子情報通信学会技術報告、Vol.95、No.206、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM95-112、pp.75-80、1995年8月。
- 652(M) 大見忠弘、白井泰雪、榑崎勝貴、「高性能・高信頼・低価格ガス供給システム」、セミコンダクターアニュアルガス供給編、臨時増刊、(ガスメディア社)、pp.14-23、1995年8月。
- 653(P) 伊野和英、山田圭一、丁剛洙、大見忠弘、「超低コンタクト抵抗を実現する自然酸化膜フリーコンタクト形成技術」、1995年ソサイエティ大会、((社)電子情報通信学会)、pp.113-114、1995年9月。
- 654(P) 竹脇利至、海原竜、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「サブクォーターマイクロンULSI用銅配線技術」、1995年ソサイエティ大会、((社)電子情報通信学会)、pp.115-116、1995年9月。
- 655(P) 島田久幸、牛木健雄、平野有一、大見忠弘、「高誘電率ゲート絶縁膜を用いた高電流駆動能力SOI MOSデバイス」、1995年ソサイエティ大会、((社)電子情報通信学会)、pp.155-156、1995年9月。
- 656(P) 柴田直、大見忠弘、「バイナリ・多値・アナログ処理をゲートレベルで融合した新しい論理演算システム」、1995年ソサイエティ大会、((社)電子情報通信学会)、pp.291-292、1995年9月。

- 657(P) 大見忠弘、「4端子デバイスエレクトロニクス」、1995年ソサイエティ特別企画講演〈シリコン材料・デバイス〉・シリコンチップに人工知能を集積する 新しいシステムアーキテクチャを実現する材料・デバイス・回路技術、1995年ソサイエティ大会、((社)電子情報通信学会)、pp.87-105、1995年9月。
- 658(M) 大見忠弘、「知能シリコンデバイス ウルトラクリーン化技術が知能を支える」、東北大学開放講座 21世紀を拓くエレクトロニクス、(東北大学教育学部附属大学教育開放センター)、pp.19-30、1995年9月。
- 659(B) 大見忠弘、「結晶成長ハンドブック」、(共立出版)、pp.810-815、1995年9月。
- 660(P) 大見忠弘、柴田直、「Intelligence Implementation on Silicon Based on Four-Terminal Device Electronics」、極限構造電子物性第151委員会第35回研究会資料、(日本学術振興会)、pp.40-47、1995年10月。
- 661(P) 大見忠弘、「完全な信頼性を有するガス供給システムが完成」、第7回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株)ベンカンUCT)、pp.2-20、1995年10月。
- 662(P) 小嶋努、米華克典、三好伸二、大見忠弘、「高性能溶接技術」、第7回高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株)ベンカンUCT)、pp.29-44、1995年10月。
- 663(M) 大見忠弘、小島泉里、「超純水と膜」、造水先端技術講習会講演要旨 最近の膜分離技術と水処理、((財)造水促進センター)、pp.87-91、1995年10月。
- 664(M) 大見忠弘、白井泰雪、「クリーンテクノロジー特集 第一部 装置およびガス供給系の表面処理技術」、日経マイクロデバイス、No.125、(日経BP社)、pp.95-101、1995年11月。
- 665(P) 大見忠弘、「変革期を迎えたシリコンテクノロジー」、大阪工業技術研究所研究講演会講演要旨集、(通商産業省工業技術院大阪工業技術研究所)、pp.30-52、1995年11月。
- 666(P) 大見忠弘、「プラズマ技術ー膜成長ー」、第24回薄膜・表面物理基礎講座表面反応を用いる薄膜・プロセス技術の基礎、(社)応用物理学会、薄膜・表面物理分科会)、pp.39-65、1995年11月。
- 667(W) 榑崎勝貴、白井泰雪、橋本泰司、中村修、松田恭司、田中純一、大見忠弘、「ウルトラクリーンガス供給技術」、第6回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.201-208、1995年11月。
- 668(W) 大見忠弘、「半導体製造技術の課題」、第6回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.265-275、1995年11月。
- 669(M) 大見忠弘、榑崎勝貴、「特殊材料ガス用酸化クロムステンレス配管システム〈耐腐食性、非触媒性、水枯れ特性に優れた表面処理技術〉」、クリーンテクノロジー、Vol.15、No.12、(日本工業出版)、1995年12月。
- 670(P) 大見忠弘、「序-大きな転換点を迎える半導体産業-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo.26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.1-2、1995年12月。
- 671(P) 大見忠弘、「Innovative Semiconductor Manufacturing by UCT」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.91-132、1995年12月。
- 672(P) 榑崎勝貴、白井泰雪、大見忠弘、「100%Cr₂O₃特殊材料ガス用供給システムの開発」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.178-187、1995年12月。
- 673(P) 谷貝道雄、城所肇、菅野洋一、梅田優、新田雄久、斉藤由雄、都田昌之、大見忠弘、「ウルトラクリーンN₂雰囲気 ウェハ搬送システム -大口径ウェハ-」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 26、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.225-234、1995年12月。
- 674(P) 大見忠弘、「半導体製造コストを下げる標準化とその展望」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.7、No.5、6、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-6、1995年12月。
- 675(B) 大見忠弘、「(アドバンストエレクトロニクスシリーズ I - 15)ウルトラクリーンULSI技術」、(培風館)、1995年12月。